

<<MOS集成电路工艺与制造技术>>

图书基本信息

书名：<<MOS集成电路工艺与制造技术>>

13位ISBN编号：9787547809808

10位ISBN编号：7547809804

出版时间：2012-4

出版时间：上海科学技术出版社

作者：潘桂忠

页数：489

字数：670000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<MOS集成电路工艺与制造技术>>

内容概要

本书编著者潘桂忠。

《MOS集成电路工艺与制造技术》内容系统地介绍了硅集成电路制造技术中的基础工艺，内容包括硅衬底与清洗、氧化、扩散、离子注入、外延、化学气相淀积、光刻与腐蚀 / N，蚀、金属化与多层布线、表面钝化以及工艺集成制造技术。

前面1—10章，一方面介绍了各种工艺，建立了工艺规范并确定了其规范号；另一方面确定了工艺制程中的各种工序。

集成电路工艺制程依一定次序的各工序组成，而工序由各工步所构成，工步中的各种工艺由其规范来确定，工艺规范由其规范号和工艺序号(i)得到，最终在硅衬底上实现所设计的图形，制造出各种电路芯片。

前面1~10章为后面11~13章的各种工艺集成制造技术奠定了基础。

11~13章介绍了CMOS

和LV / HV兼容

CMOS、BiCMOS和LV / HV兼容BiCMOS以及BCD工艺集成制造技术，给出部分实用简明工艺制程卡，并与工艺制程的剖面结构相对应。

<<MOS集成电路工艺与制造技术>>

书籍目录

第1章 硅衬底与清洗

- 1.1 硅晶圆
- 1.2 P型硅衬底
- 1.3 N型硅衬底
- 1.4 Pepi / P或Pepi / P+型硅衬底
- 1.5 Nepi / P或Nepi / N+型硅衬底
- 1.6 硅片激光编号
- 1.7 硅片清洗分类及其步骤
- 1.8 硅片各种清洗液及其清洗

第2章 热氧化

第3章 热扩散

第4章 离子注入及其退伙

第5章 硅外延

第6章 化学气相淀积

第7章 光刻

第8章 腐蚀和刻蚀

第9章 金属化

第10章 表面钝化

第11章 CMOS工艺集成

第13章 Bicmos工艺集成

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>